

珠海智融科技有限公司

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD

SW6121 原理图设计指南

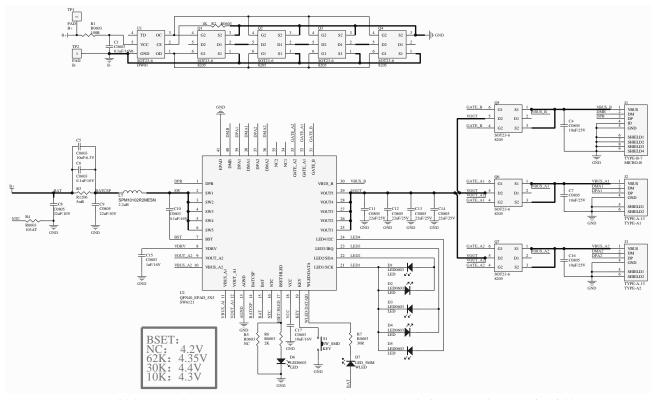
1. 版本历史

V1.0 初始版本;

V2.0 增加 Lightning 口解密等功能描述;

2. SW6121 原理图参考设计

2.1 SW6121+A+A+B+LED



- (1)、电池端采样电阻采用 5mΩ合金电阻, 封装 1206, 精度 1%以内, 温度系数小于 100PPM;
- (2)、电池端采样电阻两边接 22uF/10V 陶瓷电容, 封装 0805; 采样电阻并联 0.1uF/16V 及 10uF/6.3V 陶瓷电容, 0.1uF/16V 靠近采样电阻摆放, 10uF/6.3V 靠近芯片 BAT/BATCSP Pin 端摆放;
 - (3)、电感采用 2.2uH 感值,要求饱和电流 10A 以上,DCR 小于 $8m\Omega$;
- (4)、VOUT 端要求 4 颗封装 0805 以上、容值 22uF/25V 的陶瓷电容,如果要求输出电压纹波足够小,可以根据需求增加滤波电容的数量;
 - (5)、通路管使用 NMOS,可采用 8205 里的两颗 NMOS 并联使用,减小通路内阻;
- (6)、Type-A1/Type-A2 轻载检测采用检测通路管 NMOS 压降来实现,轻载电流为 60mA@10m Ω ,选用不同通路管时需考虑对轻载检测电流门限的影响;
- (7)、VOUT_A1/VBUS_A1、VOUT_A2/VBUS_A2为 Type-A1、Type-A2的轻载检测采样点,需直接从 Type-A1、Type-A2的通路管的 D/S 端连接,不能有任何共用电流路径;

Mode: iSW_Release_SCH009_v2.0



珠海智融科技有限公司

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

- (8)、通路管驱动采用 Chargepump,驱动能力很弱,需要选用 GS 漏电(IGSS) 100nA 的 NMOS 管;
- (9)、NTC 引脚接 NTC 电阻 103AT,可通过串并联电阻的方式调整保护温度,通过并联大电阻可将低温值调低,通过串联小电阻可将高温值调高,如果不使用 NTC 功能,NTC 引脚直接接地;
- (10)、BSET/HLED 引脚为复用引脚,可通过 BSET 设置充电目标电压;快充指示灯的限流电阻 R6 取值采用 $2K\Omega$,过小会影响 Boost 效率及发热;
- (11)、通路管到各接口母座需接 10uF 或 22uF/耐压 16V 以上的滤波电容,尤其是 Type-A1/Type-A2 母座,不接会影响负载接入检测功能;
- (12)、VCC 为内部供电电源,滤波电容 10uF/16V,关机时输出电压为电池电压,开机时输出 5V,负载能力 60mA;如需给外部器件供电尽量不要超过 20mA,避免芯片效率降低及发热;
 - (13)、VDRV 为功率管驱动电源,滤波电容 1uF/16V,关机时关闭,开机时输出 5V;
 - (14)、电池保护板至少接 4 颗 8205,或使用其他低内阻的保护板,尽量做到总内阻低于 $10m\Omega$;
 - (15)、支持 3~5 颗 LED 灯,按照 D1~D5 的顺序连接;
 - (16)、不使用手电时, D7 及 R7 悬空即可;
- (17)、WLED/DATA 可配置为 Lightning 口解密功能,可用于 Lightning 口的线缆解密,从而省去外部解密芯片:
 - (18)、其他输入输出口方案的参考设计,可参考 SW6106 参考设计。

Mode: iSW_Release_SCH009_v2.0 www.ismartware.com



珠海智融科技有限公司

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

3. 元器件选型

3.1 电阻选型

电池电流采样电阻的选型要求为: 阻值 5mohm 合金电阻, 封装 1206, 精度 1%, 温度系数<100PPM; 其他电阻, 除标明要求 1%外, 精度 5%即可, 封装根据功率要求及 PCB layout 方便决定。

3.2 电容选型

- (1)、电池端滤波电容,陶瓷电容,容值 22uF,0805 封装,耐压 10V 及以上;
- (2)、VOUT 端滤波电容,陶瓷电容,容值 22uF,0805 或 1206 封装,耐压 25V 及以上;
- (3)、USB 母座端滤波电容,陶瓷电容,容值 10uF 或 22uF, 0805 封装,耐压 16V 及以上;
- (4)、其他低容值电容采用封装0603或0402,耐压根据标注的陶瓷电容。

3.3 电感选型

电感选型建议: 感值 2.2uH, 电感饱和电流 10A 以上, DCR 小于 8m Ω, 推荐 SPM10102R2MESN;

3.4 通路管选型

通路管选用 NMOS, NMOS 的选型要求为: VDS 耐压 20V, VGS 耐压 12V, Rdson<20m Ω @VGS=4.5V, 可采用两颗并联降低内阻, 如一颗 8205 内的 2 颗 NMOS 并联使用。

下表为推荐的几种 NMOS 型号:

型号	Rds_on/m Ω (Vgs=4.5V)	Vds_max/V	Vgs_max/V	厂家
8205	25	20	12	
AO3420	18	20	12	ALPHA&OMEGA

Mode: iSW_Release_SCH009_v2.0 www.ismartware.com